次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後	改正前
次の第一号から第三号までに掲げる端末機器に付する文字等の表示については、その各号列記の順に行うものとする。 ［一・二　略］ 三　登録外国適合性評価機関の区別（三桁） 登録外国適合性評価機関 ／ 区別 ［略］ DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC. ／ 222 HCT America, Inc. ／ 223	次の第一号から第三号までに掲げる端末機器に付する文字等の表示については、その各号列記の順に行うものとする。 ［一・二　同上］ 三　登録外国適合性評価機関の区別（三桁） 登録外国適合性評価機関 ／ 区別 ［同左］ DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC. ／ 222
備考　表中の［　］の記載は注記である。	

○総務省・財務省・経済産業省告示第一号

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（令和二年法律第三十七号）第六条第一項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の一部を次の表のように改正し、同条第五項の規定に基づき公表する。

令和七年五月二十二日

総務大臣　村上誠一郎
財務大臣臨時代理
国務大臣　村上誠一郎
経済産業大臣　武藤　容治

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
第四　特定半導体生産施設整備等に関する事項 第三に規定する意義を踏まえ、基本的な方向を実現するものとして、特定半導体生産施設整備等に関する事項を定める。 一　特定半導体生産施設整備等の内容 特定半導体生産施設整備等の内容は、次の1から14までのいずれにも該当するものとする。 1～11　（略）	第四　特定半導体生産施設整備等に関する事項 第三に規定する意義を踏まえ、基本的な方向を実現するものとして、特定半導体生産施設整備等に関する事項を定める。 一　特定半導体生産施設整備等の内容 特定半導体生産施設整備等の内容は、次の1から13までのいずれにも該当するものとする。 1～11　（略）
12　特定半導体の生産施設において適切に生産が行われるよう人材を確保するものであること。また、次の(1)と(2)のいずれも満たすこと。 (1)　原則として、半導体人材育成に取り組む産学連携組織に加入し、又は当該組織の活動に参加すること。 (2)　特定半導体生産施設整備等計画における設備投資を開始した翌事業年度から当該計画における設備投資が終了するまでの間、関係する教育機関、研究機関又は技術研究組合等と連携し、及び(1)に規定する産学連携組織の半導体人材育成に係る活動に貢献すること。 13　（略） 14　国際情勢や市況の変化等を踏まえ、必要に応じて特定半導体生産施設整備等計画を見直すことができるものであること。 二　（略） 三　特定半導体生産施設整備等の促進に当たって配慮すべき事項 1～3　（略） 4　国は、特定半導体生産施設整備等計画の認定及び経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則（令和二年経済産業省令第六十八号）第十五条第二項に規定する報告の際に、有識者等の意見を聴取した上で、その内容を踏まえて当該計画の適切性及び進捗状況を確認するものとする。	12　特定半導体の生産施設において適切に生産が行われるよう人材を確保するものであること。 13　（略） （新設） 二　（略） 三　特定半導体生産施設整備等の促進に当たって配慮すべき事項 1～3　（略） （新設）

附　則

1　この告示は、公布の日から施行する。

2　この告示の施行の日前に、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十一条第三項に規定する認定を受けた特定半導体生産施設整備等計画については、この告示による改正後の第四の三の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。